### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平11-8437

(43)公開日 平成11年(1999)1月12日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

FΙ

H01S 3/18 H01L 33/00

H01S 3/18

H01L 33/00

С

審査請求 有 請求項の数10 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平9-156795

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

(22)出願日 平成9年(1997)6月13日

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 木村 明隆

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 砂川 晴夫

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

· 式会社内

(72)発明者 仁道 正明

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)

最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 窒化物系化合物半導体およびその結晶成長方法および窒化ガリウム系発光素子

#### (57)【要約】

【課題】 結晶性が良くかつクラック密度の小さく、サファイア基板上に基板とへき開面が一致する窒化ガリウム系化合物半導体層を形成するための結晶成長方法を提供し、結晶性がよく、歩留まりの高い窒化ガリウム系発光素子を実現する。

